
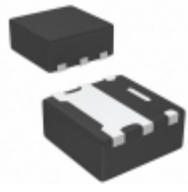



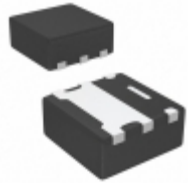



	<h2>SIB414DK-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIB414DK-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 8V 9A PPAK SC75-6</p> <p>Datenblätter:  SIB414DK-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 12000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIB414DK-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 8V 9A PPAK SC75-6
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	12000 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SC-75-6L
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SC-75-6L Single
Verlustleistung (max)	2.4W (Ta), 13W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	8V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	26 mOhm @ 7.9A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	14.03nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	732pF @ 4V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

SIB414DK-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SIB414DK-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SIB414DK-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SIB414DK-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SIB417DK-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 8V 9A SC75-6</p>	 <p>SIB417AEDK-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 8V 9A PWRPACK</p>	 <p>SIB413DK-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 9A SC75-6</p>	 <p>SIB417AEDK-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 8V 9A PWRPACK</p>
 <p>SIB415DK-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 30V 9A SC75-6</p>	 <p>SIB412DK-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 9A SC75-6</p>	 <p>SIB413DK-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 9A SC75-6</p>	 <p>SIB412DK-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 20V 9A SC75-6</p>

heiße Teile

Mehr

08055A600FAT2A	1812AA102KAT9A	6MBI35U4A-120	ACPM-7777-TR1	AD5258BRMZ10
AD586ARZ-REEL	AS172-73LF	B39941B7820C710S	BRL2012T470M	C1608C0G1H120JT000A
CAT4002BTD-GT3	CC0201JRNPO9B9N330	CGA5F4C0G2J821J085AA	CL05C2R4CB5N9NC	DS1232LPS-2+T&R
FDMC15N06	FSUSB31L8X	GM8120SF-BD	GRM2195C2A9R9DZ01D	INN3166C-H101-TL
MC10E141FN	MC10EL07DR2G	MINHAM1C21	MMBZ5241B	MT6225SA
P0403BKB	REF2930AIDBZRG4	RJK0851DPB	RK73H2ATTD3161F	S-80824ANMP-EDM-T2
SIA920DJ-T1-GE3	SIB414DK-T1-GE3	SIB422EDK-T1-GE3	SIB422EDK-T1-GE3	SIB437EDKT-T1-GE3
SIB437EDKT-T1-GE3	SIB900EDK-T1-GE3	SIB900EDK-T1-GE3	SIB911DK-T1-GE3	SIB911DK-T1-GE3
SIBA 10.NH000	SM2213PSQG	SMBJ51A-E3/52	SMBJ6.8A	SMD1812P075TS/24
SN74CBT3126PWR	SN74LVC32ANSR	TDA7563BH	TPS73132DBVR	WM8994ECS

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited